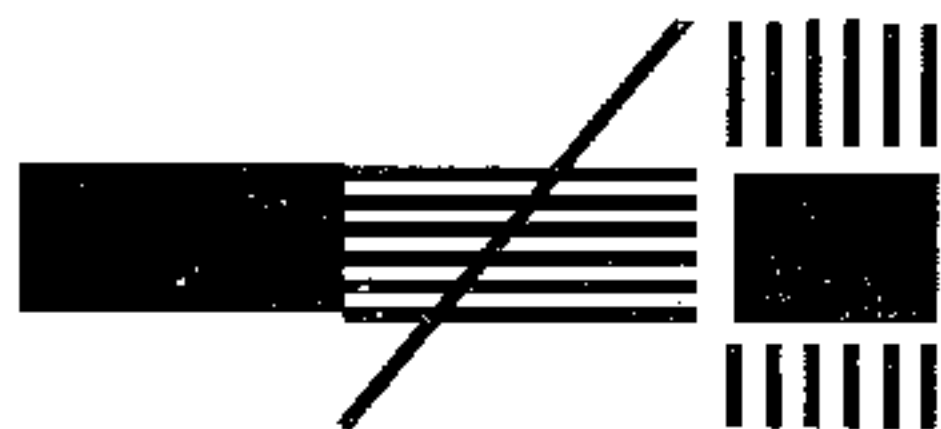




2П7165 А-5

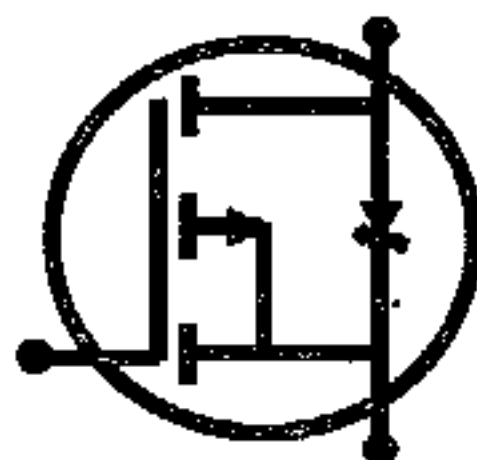
2П7165 Б-5

2П7165 В-5

2П7165 Г-5

2П7165 Д-5

2П7165 Е-5

P-канальный ДМОП транзистор логического уровня $U_{си} = -30 \text{ В}$ $R_{си \text{ откp}} = 0,050 \text{ Ом}$ 

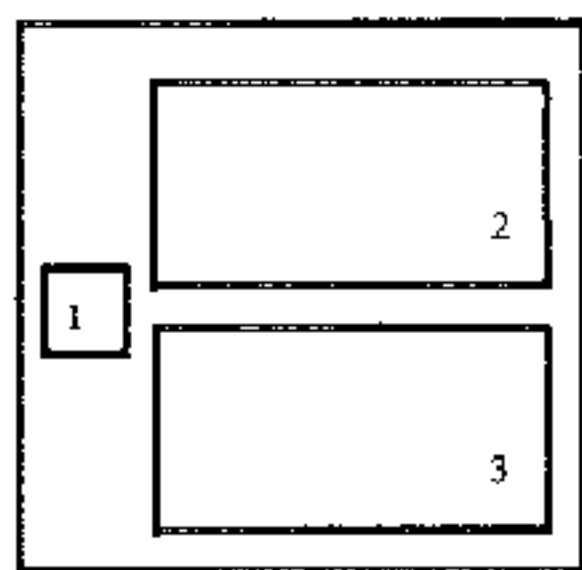
ОСОБЕННОСТИ:

- Супервысокая плотность упаковки ячеек, обеспечивающая низкое сопротивление сток-исток в открытом состоянии.
- Возможность параллельного включения.
- Рабочая температура $-60^{\circ}\text{C} \div +125^{\circ}\text{C}$
- Повышенная стойкость к спецвоздействию
- Для применения в аппаратуре специального назначения

1. Электрические параметры транзистора на пластине при $T=25^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра		Букв. обознач.	Мин	Макс	Ед. измер	Режимы измерения
Пороговое напряжения	2П7165 А-5	$U_{зи(\text{пор})}$	-0,7	-2,2	В	$U_{зи}=U_{си}$ $I_c=10\text{мА}$
	2П7165 Б-5		-0,7	-1,0		
	2П7165 В-5		-1,0	-1,3		
	2П7165 Г-5		-1,3	-1,6		
	2П7165 Д-5		-1,6	-1,9		
	2П7165 Е-5		-1,9	-2,2		
Начальный ток стока		$I_{снач}$	-	0,25	мА	$U_{си} = -30\text{В}, U_{зи}=0\text{В}$
Ток утечки затвора		$I_{зут}$	-	100	нА	$U_{зи}=20\text{В}, U_{си}=0\text{В}$
			-	-100		$U_{зи}=-20\text{В}, U_{си}=0\text{В}$
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии		$R_{си (\text{откр})}$	-	0,050	Ом	$U_{зи} = -5\text{В}, I_c=3\text{А}$

2. Габаритный чертеж кристалла.



- 1- Затвор транзистора
2; 3 - Исток транзистора
4 - Сток транзистора (подложка кристалла)

3. Справочная информация:

3.1 Размер кристалла	3,3 x 3,4 мм
3.2 Толщина кристалла	280мкм
3.3 Металлизация истока, затвора (Al)	3,0мкм
3.4 Обратная сторона кристалла (Ti/Ni/Ag)	2,5мкм

ОАО "АНГСТРЕМ"

Россия, 124460, Москва, Зеленоград

Телефон (095) 531-49-06, 532-96-21

Факс (095) 531-32-70

E-mail: market@angstrem.ruwww.angstrem.ru

JSC "ANGSTREM"

Russia, 124460, Moscow, Zelenograd

Phone (095) 531-49-06, 532-96-21

Fax (095) 531-32-70

E-mail: market@angstrem.ruwww.angstrem.ru